

Тематический указатель статей, опубликованных в 2015 году

Материалы электронной техники

- Авров Д.Д., Лебедев А.О., Таиров Ю.М.* Основные дефекты в слитках и эпитаксиальных слоях карбида кремния. I. Дислокационная структура и морфологические дефекты. Обзор. Т. 20, № 3, с. 225–238.
- Авров Д.Д., Лебедев А.О., Таиров Ю.М.* Основные дефекты в слитках и эпитаксиальных слоях карбида кремния. II. Микропоры. Малоугловые границы. Дефекты упаковки. Обзор. Т. 20, № 4, с. 337–349.
- Алдаев А., Данилюк А.Л., Лабунов В.А., Прищепина С.Л., Павлов А.А., Басаев А.С., Шаман Ю.П.* Взаимодействие электромагнитного излучения с магнитно-функционализированным УНТ-наноккомпозитом в субтерагерцовом диапазоне частот. Т. 20, № 4, с. 357–364.
- Бокова А.М., Тучин А.В., Битюцкая Л.А.* Исследование мультиграфеновых структур на основе квантово-химической модели. Т. 20, № 1, с. 5–9.
- Вигдорovich Е.Н.* Возможности улучшения функциональных характеристик нитрида галлия при эпитаксии из газовой фазы. Т. 20, № 4, с. 350–356.
- Голубятников В.А., Лысенко А.П., Белов А.Г., Каневский В.Е.* Метод исследования гальваномагнитных свойств $Cd_xHg_{1-x}Te$ и $Cd_xHg_{1-x}Te/Cd_{1-y}Zn_yTe$. Т. 20, № 6, с. 576–581.
- Дормидонтов А.Н.* Влияние нестационарных воздействий на концентрационную микро неоднородность при выращивании кристаллов методом вертикальной направленной кристаллизации. Т. 20, № 1, с. 17–22.
- Завгородняя М.И., Лавров И.В.* Методы учета случайности формы включений при вычислении эффективных диэлектрических характеристик гетерогенных текстурированных материалов. Т. 20, № 6, с. 565–575.
- Ловыгин М.В., Боргардт Н.И., Зайбт М., Казаков И.П., Цикунов А.В.* Исследование структуры тонкого слоя алюминия на вицинальной поверхности подложки арсенида галлия методом высокоразрешающей электронной микроскопии. Т. 20, № 1, с. 10–16.

Технология микро- и нанoeлектроники

- Козлов А.В., Королёв М.А., Петрунина С.С.* Математическое моделирование влияния концентрации примеси на величину тока стока КНИ полевого датчика Холла. Т. 20, № 4, с. 377–381.
- Кузнецов В.И.* Атомно-слоевое осаждение: реакторы и применение. Т. 20, № 4, с. 365–376.
- Лаврентьев К.К., Неволин В.К., Розанов Р.Ю., Царик К.А., Зайцев А.А.* Формирование наноразмерных элементов затворов СВЧ-транзисторов методом ионно-лучевой литографии. Т. 20, № 6, с. 591–597.
- Пятилова О.В., Сыса А.В., Гаврилов С.А., Якимова Л.В., Павлов А.А., Белов А.Н., Раскин А.А.* Влияние переноса ионов Ag^+ на локализацию металл-стимулированного травления поверхности кремния. Т. 20, № 6, с. 582–590.

Микроэлектронные приборы и системы

- Белин А.М., Золотарев В.И., Никифоров А.Ю., Попов А.Д.* КМОП-матрица формата 320×240 элементов для спектрального диапазона 3–5 мкм на основе PtSi. Т. 20, № 3, с. 246–251.
- Вернер В.Д., Луканов Н.М., Сауров А.Н.* Конструктивно-технологический базис на основе полностью самосовмещенных структур для терагерцовых БИС. Т. 20, № 1, с. 23–30.
- Григорьев Ф.И., Александрова А.Б., Гафуров В.А.* Методика расчета тепловых характеристик кремниевых ограничителей напряжения в импульсном режиме. Т. 20, № 3, с. 239–245.
- Демьяненко А.В.* Особенности влияния тока питания на режим работы генератора на лавинно-пролетном диоде с учетом характеристик отраженного сигнала. Т. 20, № 2, с. 120–126.
- Дюжеев Н.А., Мазуркин Н.С., Поздняков В.С., Юров А.С., Чиненков М.Ю.* Преобразователи магнитного поля на основе анизотропных магниторезистивных тонкопленочных структур для работы в широком диапазоне температур. Т. 20, № 2, с. 113–119.
- Егоркин В.И., Зайцев А.А., Шмелев С.С.* Исследование СВЧ-транзистора с субмикронным Т-образным затвором, изготовленным методом наноимпринт литографии. Т. 20, № 1, с. 31–37.

Жуков А.А., Попова Е.В., Герасименко Н.Н. Методы подавления оптической связи между ячейками матрицы кремниевых фотоумножителей. Т. 20, № 3, с. 252–258.

Журавлёв Д.В., Мушта А.И. Эффективность преобразования частоты на наноразмерных МОП-транзисторах с индуцированным каналом в интенсивной помеховой обстановке. Т. 20, № 4, с. 382–390.

Петросянц К.О., Попов Д.А., Самбурский Л.М., Харитонов И.А. Анализ средствами TCAD токов утечки 45-нм МОП транзисторной структуры с high-*k* диэлектриком. Т. 20, № 1, с. 38–43.

Садков В.Д., Лопаткин А.В. Уточненная модель низкоомных пленочных резисторов с гребенчатой структурой. Т. 20, № 6, с. 607–615.

Сергеев В.А., Фролов И.В., Широков А.А. Двухсекционная низкочастотная эквивалентная схема зеленых InGaN-светодиодов для описания шумовых характеристик. Т. 20, № 6, с. 598–606.

Сурин Ю.В., Спиридонов А.Б., Лицоев С.В. Разработка и исследование МДП-варикапов с переносом заряда. Т. 20, № 4, с. 391–396.

Тимошенко С.П., Самойликов В.К., Евстафьев С.С., Терещенко А.М., Бритков И.М. Распределение температуры по длине термомеханического актюатора. Т. 20, № 4, с. 397–404.

Нанотехнология

Агеев О.А., Быков Ал.В., Коломийцев А.С., Коноплев Б.Г., Рубашкина М.В., Смирнов В.А., Цуканова О.Г. Исследование методов модификации зондов для атомно-силовой микроскопии критических размеров осаждением углеродных нанотрубок. Т. 20, № 2, с. 127–136.

Ахмадишина К.Ф., Бобринецкий И.И., Комаров И.А., Маловичко А.М., Неволин В.К., Фёдоров Г.Е., Головин А.В., Залевский А.О., Айдарханов Р.Д. Быстродействующие биологические сенсоры на основе однослойных углеродных нанотрубок, модифицированных специфичными аптамерами. Т. 20, № 2, с. 137–144.

Левин Д.Д., Бобринецкий И.И., Емельянов А.В., Неволин В.К., Ромашкин А.В., Петухов В.А. Особенности функционализации поверхности однослойного и мультислойного графена при окислении под действием ультрафиолетового облучения. Т. 20, № 3, с. 259–267.

Схемотехника и проектирование

Бачманов В.А., Заболотнов И.В., Лапин А.В. Применение табличных моделей туннельных эффектов для ускорения SPICE-моделирования нанометровых МОП-транзисторов. Т. 20, № 6, с. 616–624.

Голицын А.А. Схема управления питанием носимого прибора наблюдения. Т. 20, № 3, с. 275–281.

Ильин С.А. Выбор базовых схемотехнических решений для проектирования библиотек цифровых ячеек. Т. 20, № 1, с. 44–49.

Мамутова О.В., Ненашев О.В., Филиппов А.С. Оснащение систем на кристалле средствами эмуляции сбоев в памяти. Т. 20, № 1, с. 50–57.

Певцов Е.Ф., Сигов А.С., Шнякин А.А. Проектирование многоэлементного теплового приемника инфракрасного излучения. Т. 20, № 3, с. 268–274.

Чебыкин А.Г., Меркутов А.С. Маршрут автоматизированного проектирования устройств формирования и обработки сигналов для спутниковых навигационных систем. Т. 20, № 2, с. 145–153.

Микро- и наносистемная техника

Тимошенко С.П., Симонов Б.М., Бритков О.М., Анчутин С.А., Тимошенко А.С. Балансировка кремниевых датчиков угловой скорости в процессе изготовления. Т. 20, № 1, с. 58–67.

Информационные технологии

Баин А.М., Портнов Е.М., Чжо Зо Е. Способ централизованного контроля магистральных объектов с различными приоритетами. Т. 20, № 2, с. 154–160.

Голованов Р.В., Прокофьев А.А. Алгоритм JPEG-IT, повышающий сжатие изображений. Т. 20, № 1, с. 75–82.

Гурьянов М.А., Прокофьев А.А. Автоподбор параметров синтеза радиолокационного изображения, полученного с радиолокатора с синтезированной апертурой. Т. 20, № 2, с. 161–167.

Джиган В.И., Смекалов А.И. Цифровой синтезатор с прямым вычислением гармонического сигнала. Т. 20, № 6, с. 625–633.

Корнеев В.В., Семенов Д.В., Телегин П.Н., Шабанов Б.М. Отказоустойчивое децентрализованное управление ресурсами грид. Т. 20, № 1, с. 83–90.

Овчинников А.В., Фан Ч.Х. Определение навигационных параметров подвижных объектов на основе полусферического оптико-электронного преобразователя. Т. 20, № 1, с. 91–99.

Переверзев А.Л., Силантьев А.М. Анализ проблем создания платформонезависимого HDL-описания модуля быстрого преобразования Фурье. Т. 20, № 6, с. 634–643.

Соколов С.В. Решение навигационной задачи на основе моделей пространственных траекторий. Т. 20, № 4, с. 414–420.

Соловьев А.Н., Калеев Д.В. Оценка и выбор параметров инерциальной навигационной системы для работы в составе многоантенной системы. Т. 20, № 1, с. 68–74.

Умняшкин С.В., Шаронов И.О. Компенсация движения для видеокодирования на основе гексагональных блоков. Т. 20, № 4, с. 405–413.

Интегральные радиоэлектронные устройства

Гуреев А.В. Энергетические характеристики распространения электромагнитных волн внутри зданий. Т. 20, № 4, с. 421–430.

Крыликов Н.О., Морозов Л.А., Плавич М.Л. Реализация высокоскоростных цифровых фильтров высоких порядков на основе новых поколений FPGA. Т. 20, № 3, с. 282–288.

Крыликов Н.О., Плавич М.Л. Особенности проектирования многоканального прецизионного генератора аналоговых сигналов. Т. 20, № 2, с. 168–173.

Минаков Е.И., Полинкин А.В., Мацур И.Ю. Математическая модель излучателя электронной системы радиочастотной идентификации. Т. 20, № 3, с. 296–303.

Романюк В.А., Яр Зар Хтун. Автогенератор СВЧ с низким уровнем фазового шума. Т. 20, № 3, с. 289–295.

Методы и техника измерений

Лемешко С.В., Сагунова И.В., Чаплыгин Ю.А., Шевяков В.И. Выбор оптимальных режимов измерений в сканирующей электропроводящей микроскопии. Т. 20, № 2, с. 188–194.

Ловыгин М.В., Боргардт Н.И., Бугаев А.С., Волков Р.Л., Зайбт М. Исследование структуры и состава напряженного эпитаксиального слоя в гетерокомпозиции InAlAs/GaAs(100) методами просвечивающей электронной микроскопии. Т. 20, № 4, с. 431–439.

Лысенко А.П., Белов А.Г., Голубятников В.А., Строганкова Н.И. Влияние размера области засветки образа высокоомного арсенида галлия на его проводимость. Т. 20, № 2, с. 174–181.

Сафонов С.О., Путря М.Г., Фоминых С.В. Определение электромиграционных параметров металлических проводников на основе проведения ускоренных испытаний. Т. 20, № 2, с. 182–187.

Сивченко А.С. Методика определения дефектности подзатворного диэлектрика с использованием ускоренных испытаний тестовых структур. Т. 20, № 3, с. 304–312.

Краткие сообщения

Адамов Ю.Ф., Тимошенко В.П. Компенсация саморазогрева в SiGe ГБТ. Т. 20, № 3, с. 323–326.

Дюжеев Н.А., Королёв М.А., Катеев М.В., Гусев Е.Э. Моделирование зависимости выходных характеристик первичного преобразователя датчика потока мембранного типа от его конструктивных параметров. Т. 20, № 6, с. 644–647.

Еремеев П.М. Использование кода Хэмминга для исправления двойных сбоев в смежных разрядах памяти в аппаратуре космического назначения. Т. 20, № 3, с. 321–322.

Жуков А.А., Ильин Е.Ю., Герасименко Н.Н. Влияние режимов фотолитографического цикла на величину отрицательного угла маски из позитивного фоторезиста. Т. 20, № 4, с. 440–442.

Заворотный А.А., Филиппов В.В. Зондовые измерения эффекта Холла в анизотропных пластинах и пленках. Т. 20, № 2, с. 195–198.

Минаков Е.И., Калистратов Д.С. Применение гибридных аналогово-цифровых систем для повышения эффективности телевизионных изображений. Т. 20, № 1, с. 100–102.

Неустров С.А. Теплоемкость продукта термодеструкции алмаза. Т. 20, № 2, с. 201–202.

Пашилкин А.С., Михайлова М.С. Анализ термодинамических функций твердого теллурида висмута. Т. 20, № 2, с. 198–200.

Петросянец К.О., Кожухов М.В. Влияние параметров слоя кремний-германиевой базы на эффект саморазогрева в структуре гетеропереходного биполярного транзистора. Т. 20, № 6, с. 648–651.

Романюк В.А., Яр Зар Хтун. Уменьшение фазового шума источников СВЧ-колебаний путем совместного использования автогенераторов и умножителей частоты. Т. 20, № 4, с. 443–446.

Сергеев В.А., Ульянов А.В. Сравнительный анализ погрешности аппроксимации спектров излучения светодиодов различными функциями. Т. 20, № 3, с. 317–320.

Тимошенко В.П., Ваньков В.А., Стародубцев К.С. Дельта-сигма-модулятор для мультистандартной обработки сигналов. Т. 20, № 6, с. 652–655.

Тимошенко С.П., Горошко В.Н., Симонов Б.М., Калугин В.В., Шалимов А.С. Об эквивалентности физико-вероятностного и физико-статистического подходов к построению моделей надежности на примере деградации механических элементов МЭМС. Т. 20, № 2, с. 203–206.

Шаманаев С.В., Тихонов Р.Д., Черемисинов А.А., Генералов С.С., Горелов Д.В., Поломошнов С.А., Казаков Ю.В., Амеличев В.В. Локальное электрохимическое осаждение пермаллоя на кремниевые пластины с магниторезистивными наноструктурами. Т. 20, № 3, с. 313–316.

Индустрия наносистем*

Ермолаев Д.М., Земляков В.Е., Егоркин В.И., Горбацевич А.А., Шановал С.Ю. Детекторы терагерцового излучения на основе массивов полевых наногетероструктурных AlGaAs/InGaAs/GaAs транзисторов. Т. 20, № 5, с. 481–488.

Козлов А.В., Красюков А.Ю., Крупкина Т.Ю., Чаплыгин Ю.А. Моделирование характеристик и оптимизация конструктивно-технологических параметров интегральных магниточувствительных элементов в составе микро- и наносистем. Т. 20, № 5, с. 489–496.

Сауров А.Н., Булярский С.В., Рисованный В.Д., Павлов А.А., Абанин И.Е., Кицюк Е.П., Шаманаев А.А., Лебедев Е.А. Наноструктурированные источники тока, возбуждаемые β -излучением, на основе углеродных нанотрубок. Т. 20, № 5, с. 474–480.

Информационно-телекоммуникационные системы*

Амеличев В.В., Абанин И.Е., Аравин В.В., Костюк Д.В., Касаткин С.И., Резнев А.А., Сауров А.Н. Развитие технологий магнитополупроводниковых микросистем. Т. 20, № 5, с. 505–510.

Гаврилов С.В., Денисов А.Н., Коныхин В.В., Малашев Н.И., Фёдоров Р.А. Семейство серий базовых матричных кристаллов. Т. 20, № 5, с. 497–504.

Гусев Д.В., Данилова Н.Л., Литвиненко Р.С., Михайлов Ю.А., Панков В.В., Суханов В.С. Тензорезистивные МЭМС-преобразователи давления и модули на их основе. Т. 20, № 5, с. 511–515.

Науки о жизни*

Гринвальд В.М., Кузьмин Г.С., Маслобоев Ю.П., Селищев С.В., Тельшев Д.В. Первый отечественный аппарат вспомогательного кровообращения АВК-Н «Спутник» на основе имплантируемого насоса крови. Т. 20, № 5, с. 516–521.

Транспортные и космические системы*

Бахтин А.А., Тимошенко А.Г., Белоусов Е.О., Ломовская К.М. Актуальные задачи построения систем связи для напланетных и орбитальных станций. Т. 20, № 5, с. 522–529.

Чистюхин В.В., Лялин К.С., Орешкин В.И., Меркулов С.С., Мелёшин Ю.М. Проектирование излучающей апертуры АФАР самолетной РЛС переднего обзора для системы наведения и посадки в автоматическом режиме. Т. 20, № 5, с. 530–535.

*Рубрика введена для специального выпуска.

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика*

Штерн Ю.И., Кожневиков Я.С., Рыгалин Д.Б., Штерн М.Ю., Караваяев И.С., Розачев М.С. Интеллектуальная система и электронные компоненты для контроля потребления тепловой энергии. Т. 20, № 5, с. 536–542.

Безопасность и противодействие терроризму*

Бархоткин В.А., Петров В.Ф., Симонов С.Б., Корольков Д.Н., Терентьев А.И., Петров О.В., Демьянов В.В. Электронный комплекс управления для роботизированной специальной пожарной машины. Т. 20, № 5, с. 543–550.

Григорашвили Ю.Е., Бухлин А.В., Мингазин В.Т., Стицей Ю.В. Системы магнитовидения для обнаружения скрытых объектов. Т. 20, № 5, с. 551–557.

Юбилей

Буцу Виктору Петровичу – 80 лет. Т. 20, № 2, с. 218.

Быкову Дмитрию Васильевичу – 70 лет. Т. 20, № 2, с. 216–217.

Гаврилов С.А., Рыгалин Б.Н. Научно-техническая деятельность МИЭТ. Т. 20, № 5, с. 461–467.

Грибову Борису Георгиевичу – 80 лет. Т. 20, № 2, с. 214–215.

Казённову Геннадию Георгиевичу – 80 лет. Т. 20, № 1, с. 105–106.

Чаплыгин Ю.А. МИЭТу – 50! Т. 20, № 5, с. 455–460.

Чаплыгин Ю.А., Путьра М.Г., Крупкина Т.Ю. Образовательная технология подготовки и переподготовки кадров по заказам предприятий. Т. 20, № 5, с. 468–473.

Конференции

Абанин И.Е., Вернер В.Д., Ефимов А.А. Выставка «Электроника-2014» (г.Мюнхен, Германия). Т. 20, № 2, с. 207–213.

Встреча в МИЭТ с нобелевским лауреатом по физике Жоресом Ивановичем Алфёровым. Т. 20, № 6, 2-я стр. обложки.

8 февраля – День российской науки. Миэтовские научные чтения. Т. 20, № 2, 2-я стр. обложки.

Памяти Андрея Сергеевича Пашинкина. Т. 20, № 3, с. 327–328.

Памяти Вильжана Мавлютиновича Амербаева. Т. 20, № 1, с. 103–104.

Памяти Сергея Кирилловича Максимова. Т. 20, № 3, с. 329–330.

Уважаемые авторы!

С правилами оформления статей можно ознакомиться
на нашем сайте:

<http://miet.ru/structure/s/894/e/67530/35>

*Рубрика введена для специального выпуска.